(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



- 1 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1

(43) 国際公開日 2005 年3 月24 日 (24.03.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/027217 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 21/322, 27/12

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/013068

(22) 国際出願日:

2004 年9 月8 日 (08.09.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-315987 2003 年9 月8 日 (08.09.2003) JF

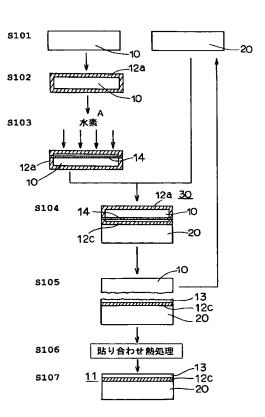
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三菱 住友シリコン株式会社 (SUMITOMO MITSUBISHI SILICON CORPORATION) [JP/JP]; 〒1058634 東京都 港区芝浦一丁目 2番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 遠藤 昭彦(ENDO,

Akihiko) [JP/JP]; 〒1058634 東京都港区芝浦一丁目 2番1号三菱住友シリコン株式会社内 Tokyo (JP). 森 本信之 (MORIMOTO, Nobuyuki) [JP/JP]; 〒1058634 東京都港区芝浦一丁目2番1号三菱住友シリコン 株式会社内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 安倍 逸郎 (ABE, Itsuro); 〒8020002 福岡県北 九州市小倉北区京町三丁目 1 4番8号 ジブラルタ 生命小倉京町ビル80A室 Fukuoka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,

/続葉有/

- (54) Title: SOI WAFER AND ITS MANUFACTURING METHOD
- (54) 発明の名称: SOIウェーハおよびその製造方法



A... HYDROGEN \$106... BONDING AND THERMAL TREATMENT (57) Abstract: A support wafer contains boron of more than 9×10¹⁸ atoms/cm³. Therefore, in the wafer bonding and thermal treatment, a part of the metal impurities in an active wafer and the metal impurities in the wafer are captured by the boron. As a result, metal contamination in the active layer is lessened. Moreover, the wafer strength is heightened, thus preventing wafer slipping. Since the wafer has no COP, micro voids are not detected in the LPD evaluation of the active layer, improving the reliability of the evaluation. Such a bonded wafer can be manufactured at low cost.

(57) 要約: 支持用ウェーハは9×10¹⁸ a toms/cm³以上のボロンを含むので、貼り合わせ熱処理時に活性層用ウェーハ中の一部の金属不純物とウェーハの金属不純物とがボロンに捕獲される。その結果、活性層の金属汚染を低減できる。しかも、ウェーハの強度が高まりウェーハのスリップの発生を防げる。ウェーハにはCOPがないので、活性層のLPD評価時、マイクロボイドを検出せず、評価の信頼性が高まる。さらに、このような貼り合わせウェーハを低コストで製造できる。

WO 2005/027217 A1

SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,

BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。